

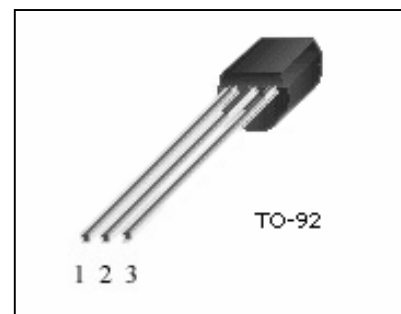
КТ209А-М

PNP КРЕМНИЕВЫЙ ЭПИТАКСИАЛЬНО – ПЛАНАРНЫЙ ТРАНЗИСТОР

аАО.336.065 ТУ/02

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РАБОТЫ В НИЗКОЧАСТОТНЫХ УСТРОЙСТВАХ
АППАРАТУРЫ ШИРОКОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

- * Зарубежный аналог – **MPS404**
- * Изготавливается в корпусе **КТ-26 (ТО-92)**.



1 – Коллектор 2 – База 3 – Эмиттер

ПРЕДЕЛЬНО- ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Параметры	Обозначение	Ед. измер.	Значение
Напряжение коллектор-база	Uкб max	В	-15-60
Напряжение коллектор-эмиттер	Uкэ max	В	-15-60
Напряжение эмиттер-база	Uэб max	В	-5-20
Постоянный ток коллектора	Iк max	мА	-300
Постоянный ток базы	Iб max	мА	-100
Импульсный ток коллектора	Iк, и max	мА	-500
Рассеиваемая мощность коллектора	Pк max	мВт	200
Температура перехода	Tj	°С	125

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (Токр.ср.=25°С)

Параметры	Обозначение	Ед. измер	Режимы измерения	Min	Max
Обратный ток коллектор-эмиттер	Iкэг	мкА	Uкэ=Uкэ max, Rбэ=10кОм		-1,0
Обратный ток эмиттера	Iэбо	мкА	Uэб=Uэб max		-1,0
Статический коэффициент передачи тока	h21E		Uкэ=-1В, Iк=-30мА Uкэ=-1В, Iк=-0,2мА	-20 -12 -30	-240 - -
Напряжение насыщения коллектор- эмиттер	Uкэ(нас)	В	Iк=-300мА, Iб=-30мА		-0,4
Напряжение насыщения база - эмиттер	Uбэ(нас)	В	Iк=-300мА, Iб=-30мА		-1,5
Модуль коэффициента передачи тока	/ h21E /		Uкб=-5В, Iэ=-10мА, f=20МГц	2	

220108, г. Минск, ул. Корженевского, 16, УП "Завод ТРАНЗИСТОР"

Отдел маркетинга: тел./факс (10-37517) 212-59-32

E-mail: market@transistor.com.by <http://www.transistor.by>

Классификация КТ209

	Укб max, В	Укэ max, В	Уэб max, В	h21e
КТ209А	-15	-15	-10	20-60
КТ209Б	-15	-15	-10	40-120
КТ209Б1	-15	-15	-5	>12
КТ209В	-15	-15	-10	80-240
КТ209В1	-15	-15	-10	>30
КТ209Г	-30	-30	-10	20-60
КТ209Д	-30	-30	-10	40-120
КТ209Е	-30	-30	-10	80-240
КТ209Ж	-45	-45	-20	20-60
КТ209И	-45	-45	-20	40-120
КТ209К	-45	-45	-20	80-160
КТ209Л	-60	-60	-20	20-60
КТ209М	-60	-60	-20	40-120